

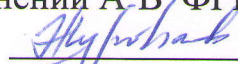
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,
Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники.

Председателю диссертационного
совета 212.268.04 на базе Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники, д.т.н.,
профессору Шандарову С.М.

Уважаемый Станислав Михайлович!

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Великовского Леонида Эдуардовича "СВЧ транзистор
миллиметрового диапазона на основе (InAlGa)N/AlN/GaN гетероструктуры с
легированными буферными слоями" по специальности 01.04.04 –
«Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР,
прилагаются.

д.ф.-м.н., заведующий лабораторией
молекулярно-лучевой эпитаксии
соединений A^3B^5 ФГБУН ИФП СО РАН

 К.С. Журавлев

Дата 20.12.2019.

Подпись Журавлева К.С. удостоверяю



Ученый секретарь
ИФП СО РАН
С.А. Аржанникова

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Великовского Леонида Эдуардовича “СВЧ транзистор миллиметрового диапазона на основе (InAlGa)N/AlN/GaN гетероструктуры с легированными буферными слоями” по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Журавлев Константин Сергеевич,
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук, 01.04.10
Ученое звание (по кафедре, специальности)	
Основное место работы	
Должность	заведующий лабораторией,
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	лаборатория молекулярно-лучевой эпитаксии соединений AzB_5
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. акад. Лаврентьева, 13 http://www.isp.nsc.ru/ +7(383)330-90-55 http://www.isp.nsc.ru/institut/kontakty-i-rekvizity
Публикации по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)	
Svit K.A., Zhuravlev K.S. On the Processes of the Self-Assembly of CdS Nanocrystal Arrays Formed by the Langmuir–Blodgett Technique// Semiconductors 53(11), p. 1540-1544, 2019.	
Bokhan P.A., Zhuravlev K.S., Zakrevvsky D.E., et al. Optical Gain in heavily doped $\text{Al}(x)\text{Ga}(1-x)\text{N}$ Structures. // Techn. Physics Letters 45(9), pp. 951-954, 2019.	
Chizh A.L., Mikitchuk K.B., Zhuravlev K.S., et.al. High-Power High-Speed Schottky Photodiodes for Analog Fiber-Optic Microwave Signal Transmission Lines// Technical Physics Letters 45(7), pp. 739-741, 2019.	
Aleksandrov I.A., Zhuravlev K.S. Energy structure and radiative lifetimes of quantum dots//Superlattices and Microstructures 113, pp. 373-378, 2018.	
Gilinsky A.M., Dmitriev D.V., Toropov A.I., Zhuravlev K.S. Defect-related luminescence in InAlAs on InP grown by molecular beam epitaxy// Semiconductor Science and Technology 32(9),095009, 2017.	

Zhuravlev K.S., Gulyaev G.V, Aleksandrov I.A., et al Original method of AlN and InGaN quantum dot formation on (0001) AlN surface by ammonia molecular beam epitaxy// J. Phys. Conf. Ser. 864(1) 012007, 2017.

Protasov D.Y., Zhuravlev K.S. The influence of impurity profiles on mobility of two-dimensional electron gas in AlGaAs/InGaAs/GaAs heterostructures modulation-doped by donors and acceptors// Solid-State Electronics 129, с. 66-72, 2017.

Официальный оппонент

К.С. Журавлев



Ученый секретарь
ИФП СО РАН
С.А. Аржанникова